# АСТРОФИЗИКА

**TOM 30** 

АПРЕЛЬ, 1989

ВЫПУСК 2

УДК: 524.37—335.7

## ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕМПЕРАТУР ЯДЕР ПЛАНЕТАРНЫХ ТУМАННОСТЕЙ

#### А. Г. ЕГИКЯН

Поступила 24 декабря 1987 Принята к печати 16 ноября 1988

Метод определения нонизационных температур ядер планетарных туманностей с помощью отношения интенсивностей двух спектральных линий иона С III — запрещенной, контролируемой столкновениями, и псевдорезонансной, контролируемой фотовонизацией, распространен на ионы Si III. Si II. Al II и Mg I, что дает возможность определять температуры ядер в широком днапазоне значений — от 40 000 К до 200 000 К. Расчет интенсивностей псевдорезонансных линий проведен с учется дивлектронной рекомбинации, которая доминирует над фоторекомбинацией в условиях планетарных туманностей. Выведенные аналитические зависимости отношений интенсивностей линий от температур ядер сравниваются с аналогичными зависимостями, полученными в результате числекных расчетов, основалных на фотовонизационных моделях туманностей. Метод применен к четырем туманностям: NGC 3918, NGC 6572, NGC 7009 и NGC 7662

1. Введение. Спектральные линии, нижние состояния которых метастабильны, в работе [1] предложено называть псевдорезонансными. Они могут представить определенный интерес для физики планетарных туманностей [2, 4, 19].

В условиях, когда псевдорезонансная линия контролируется фотоионизационными процессами, отношение ее интенсивности к интенсивности запрещенной линии, возникающей при переходах с метастабильного уровня, может зависеть от температуры центральной звезды [2]. В работе [2] вта зависимость для иона C<sup>++</sup> выведена в аналитической форме и имеет вид

$$\frac{E(1909)}{E(1176)} = 5.76 \cdot 10^{-10} \frac{n_s}{W} \frac{T_s^{-1/2}}{T_s} \exp\left[\frac{552000}{T_s} \left(1 - 0.144 \frac{T_s}{T_s}\right)\right], \quad (1)$$

где n<sub>e</sub>, T<sub>e</sub>, W и T<sub>s</sub>—соответственно электронные концентрация и температура туманности, коэффициент дилюции излучения и температура ядра.

В отличие от хорошо известных методов определения изнизационных температур (метод «О III—O II» [3]), в этом методе («С III») привлекаются линии одного и того же изна, к тому же с гораздо более близкими значениями длин воли.

Настоящая работа посвящена уточнению и расширению области применения метода «С III» при определении температур центральных звезд туманностей. При этом зависимость  $T_s$  от упомянутого отношения, полученная в [2] аналитически, сравнивается с подобной зависимостью, полученной, однако, в результате численных расчетов, основанных на фотоионизационных моделях туманностей [4]. Аналогичные аналитические формулы выводятся также для спектральных линий ионов Si III, Si II, Al II и Mg I и сравниваются с результатами соответствующих численных расчетов.

2. Аналитические формулы. Следуя работе [2], рассмотрим трехуровенную модель некоторого иона с метастабильным вторым состоянием  $(A_{21} \ll A_{32} \sim 10^8 c^{-1}, A_{31} = 0)$ . Здесь  $A_{1k}$  — вероятность радиационного перехода  $i \rightarrow k$ , i — номер состояния. Для ионон типа Si III это термы  $3s^2 {}^1S$ ,  $3s 3p {}^3P^0$  и  $3p^2 {}^3P$ , для Si II соответственно  $3s^2 3p {}^2P^0$ ,  $3s 3p^{24}P$  и  $3s 3p4s {}^4P^0$ .

Рассмотрим баланс населенностей уровней 2 и 3, вместе с условием фотоионизационного равновесия:

$$n_{2}(A_{21} + n_{e}q_{21} + n_{e}q_{23}) + n_{2}R_{2c} = n_{1}n_{e}q_{12} + n_{3}(A_{32} + n_{e}q_{32}) + n_{e}n^{+}\pi_{2},$$

$$n_{3}[A_{31} + A_{32} + n_{e}(q_{32} + q_{31})] + n_{3}R_{3c} = n_{1}n_{e}q_{13} + n_{2}n_{e}q_{23} + n_{e}n^{+}\alpha_{3},$$

$$n_{1} + n_{2} + n_{3} = n_{0},$$

$$n_{1}R_{1c} + n_{2}R_{2c} + n_{3}R_{3c} = n_{e}n^{+}\alpha_{i}.$$
(2)

Здесь q<sub>ij</sub> — коэффициенты ударных переходов,

$$q_{ij} = 8.63 \cdot 10^{-6} \cdot T_{*}^{-1,2} \frac{Q_{ii}}{g_{i}} e^{-s_{ij}/kT_{*}}, \qquad (3)$$

R, - скорость фотоионизации с уровня i:

$$R_{ie} = \int_{\gamma_i}^{\infty} W \frac{4\pi B_v (T_s)}{hv} a_{i0} \left(\frac{\gamma_i}{v}\right)^2 dv = 3.41 \cdot 10^{19} a_{i0} \chi_i^2 W T_s e^{-\frac{11600 \cdot \gamma_i}{T_s}}, \quad (4)$$

где  $\Omega_{ij}$  — сила удара,  $\epsilon_{ij}$  — разность энергий между уровнями *i* и *j* (эВ),  $g_i$  — статистический вес уровня *i*,  $a_{i0}$  — пороговое сечение фото-

ионизации, W — ковффициент дилюции излучения,  $B_v(T_s)$  — функция Планка, и для простоты в (4) принята частотная зависимость сечения фотоионизации вида  $v^{-2}$ . В (2)  $a_i$  — полная скорость рекомбинации (дивлектровная плюс фоторекомбинация),  $a_i$  — скорость рекомбинации на уровень *i*, т. е. скорость заселения данного состояния, происходящего путем радиационного распада вышележащих автоионивационных и связанных состояний, а также фоторекомбинациями.  $a^+$  он атома  $n_0$ : в условиях туманностей  $n_2 \ll n_1$  и  $n_3 \ll n_1$ , так что  $n_1 ==$  $= n_0$ , и четвертое уравнение в (2) связывает две стадии ионизации посредством фотоионизационного баланса 1 уровня. Из-за малости Wковффициенты  $R_{2c}$  и  $R_{3c}$  малы,  $\sim 10^{-6} c^{-1}$ , и ими можно пренебречь в сравнении с  $A_{21}$  и  $A_{32}$ , равными по порядку величины  $10^2$  и  $10^8 c^{-11}$ соответственно.

Легко убедиться, что в условиях планетарных туманностей решение системы (2) для рассматриваемых ионов можно записать в виде:

$$n_{2} = \frac{n_{e}n_{1}q_{12} + n_{e}n^{+}(\alpha_{2} + \alpha_{3})}{A_{21}}$$

$$n_{3} = \frac{n_{e}n_{1}q_{13} + n_{e}n^{+}\alpha_{3}}{A_{32}}$$
(5)

Тогда отношение интенсивностей интересующих нас спектральных линий, запрещенной (2→1) и псевдорезонансной (3→2) можно представить в виде:

$$\frac{n_2 A_{21} h v_{12}}{n_3 A_{32} h v_{32}} = \frac{v_{12}}{v_{23}} \frac{q_{12} + \frac{n^+}{n_1} (a_2 + a_3)}{q_{13} + \frac{n^+}{n_1} a_3}$$
(6)

Требуя выполнения условия

$$q_{12} \gg \frac{n^+}{n_1} (a_2 + a_3) \gg q_{13},$$
 (7)

нун

$$n_e q_{12} \gg R_{1e} - \frac{a_2 + a_3}{a_e} \gg n_e q_{13},$$
 (8)

что равносильно требованию о контролировании линии  $2 \rightarrow 1$  ударами, а  $3 \rightarrow 2$  — фотоионизадией, получим искомую зависимость между параметрами туманности и ионизационной температурой ядра. Легко показать, что (8) выполняется при  $W \leq 10^{-14}$ ,  $n_{\sigma} \sim 10^4$  см<sup>-3</sup> и эначениях электронной -температуры T<sub>e</sub>, соответствующих данному классу возбуждения туманности (табл. 2).

Таким образом, для отношения интенсивностей линий в переходах  $2 \rightarrow 1 (3s3p \, {}^{3}P^{0} - 3s^{2} \, {}^{1}S_{0})$  с длиной волны  $\lambda_{1}$  и  $3 \rightarrow 2 (3p^{2} \, {}^{3}P - 3s3p^{3}F^{0})$ с длиной волны  $\lambda_{2}$  ионов SiIII –  $\lambda$  1888, 1300 A; Al II –  $\lambda\lambda$  2666, 1766 A и Mg I –  $\lambda\lambda$  4568, 2780 A, получаем

$$R = \frac{E(\lambda_1)}{E(\lambda_2)} = 2.53 \cdot 10^{-25} \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \frac{Q_{12}}{a_{10}g_1\chi_1^2} \frac{a_i}{a_3} \frac{n_e T_e^{-1/2}}{W T_e} \frac{\frac{11600 \cdot \chi_1}{T_e} \left(1 - \frac{\kappa_{12} T_e}{\chi_1 T_e}\right)}{W T_e}, \quad (9)$$

тде  $\gamma_1$  — потенциал ионизации 1 уровня (эВ),  $\varepsilon_{12} = 12398.5/\lambda_1$  эВ ( $\lambda_1$  в А). Формула (9) верна и для пары линий иона Si II  $\lambda_1 2334$ , переход  $2 \rightarrow 1 (3s3p^2 {}^4P - 3s^33p {}^3P^0)$  и  $\lambda_2 1351$ , переход  $3 \rightarrow 2 (3s3p4s {}^4P^0 - 3s3p^2 {}^4P)$ .

Поскольку для данного класса возбуждения туманности будет наблюдаться свой набор линий, можно получить границы применимости (9) для того или иного иона, требуя, например, чтобы имело место

 $E(\lambda_{\star}) > 10^{-3} E_{\theta}, \qquad (10)$ 

где  $E_{\rm p} = 1.13 \cdot 10^{-21} \cdot n_e^2 / T_e$  эрг см<sup>-3</sup> с<sup>-1</sup> [13] — интенсивность в линии  $H_{\rm p}$ , т. к. в противном случае линию  $\lambda_1$  вообще нельзя будет зарегистрировать в спектре туманности. Используя найденные посредством численных расчетов (см. раздел 3) значения концентраций ионов (с учетом всех стадий ионизаций), можно показать, что (10) выполняется при следующих значениях  $T_s$  и при концентрации атомов водорода  $n_{\rm H} \sim 10^4$  см<sup>-3</sup> и нормальном химическом составе: С III и Si III —  $T_s \ge 60\,000$  K, Si II —  $-50\,000$  K  $\le T_s \le 100\,000$  K, Al II —  $50\,000$  K  $\le T_s \le 80\,000$  K.

Рассмотрим более подробно множитель  $\alpha_t/\alpha_3$  в (9). В работе [6] была установлена необходимость учета процесса диэлектронной рекомбинации при расчетах интенсивностей линий С III, контролируемых фотоионизацией, в условиях планетарных туманностей. Очевидно, что у рассматриваемых ионов диэлектронная рекомбинация будет играть такую же важную роль, поэтому попытаемся ее учесть при расчете величины  $\alpha_3$ . В [6] при расчете скорости диэлектронной рекомбинации учитывались стабилиянрующие радиационные распады автоионизационных уровней, происходящие с участием захваченного электрона: в этом случае диэлектронная рекомбинация будет доминировать над фоторекомбинацией. Кстати, возможность осуществления подобных переходов внешних электронов при диэлектронной рекомбинации подтверждается лабораторными данными, в частности для Mg I, в спектре которого наблюдаются соответствующие лини [12]. Мы будем учитывать радиационные распады автоионизационные

273

#### А. Г. ЕГИКЯН

ных состояний 3р4f и 3р5f для Si III, 3р3d для Mg I и 3s3р4р для Si II, происходящие с участием внешнего влектрона. В (9) аз есть не что иное, как эффективный ковффициент рекомбинации состояния 3:

$$a_3 = \sum_{i=3}^{n} a_i C_{i3}, \tag{11}$$

где  $\alpha_i$  — коэффициент рекомбинации на уровень *i*,  $C_{i3}$  — элементы каскадной матрицы Ситона [9]. В (11) мы исходим из особенностей энергетического спектра ионов Si III, Si II, Al II и Mg I, пренебрегая в частности, двухэлектронными переходами, при этом в сумме (11) остается всего несколько членов. При вычислении  $\alpha_i$  используем скорости диэлектронной рекомбинации этих ионов [6—8]. Тогда  $\alpha_i$  есть доля радиационных распадов, приводящих к заселению состояния 3 (соответствующее  $C_{i3} \leq 1$ ); среди всех возможных, с участием внешнего электрона. Вероятности как этих переходов, так и входящих в  $C_{i3}$  вычислялись в кулоновском приближении [14], либо принимались водородоподобными. Численные оценки показывают, что фоторекомбинацией при этом можно пренебречь.

В случае Al II  $\alpha_i$  была вычислена как сумма  $\sum_{n < \gamma} \alpha_n + \sum_{n > \gamma} \alpha_n$ , в ко-

торой первое слагаемое есть сумма фоторекомбинаций на все уровни ниже терма 3p<sup>2</sup> <sup>1</sup>S (они вычислены по формулам [15]), а соответствующие пороговые сечения фотоионизации — по [16]), и выше — в этом случае ионы считаются водородоподобными, а суммирование осуществляется согласно [9]. Скорость полной дивлектронной рекомбинации для Al II взята из работы [7] — она примерно в 2—3 раза больше скорости фоторекомбинации. Однако применить изложенный выше способ расчета аз для Al II с учетом дивлектронной рекомбинации не удалось, т. к. автононизационные состояния Al II в лабораторном спектре не наблюдаются [11]. Поэтому при расчете αз пришлось ограничиться учетом только фоторекомбинации. Результаты вычислений аг и аз приведены в табл. 1. Они свидетельствуют о том, что значения аз для Al II, по-видимому, занижены. Для практического использования (9) необходимо знание атомных параметров — все они собраны в табл. 1 из источников [4-12, 14-16, 21-24]. Отметим, что множитель  $\alpha_l/\alpha_3$  для рассматриваемых ионов (кроме Al II) изменяется в указанных пределах Te примерно в 3-7 раз. Для Al II это отношение в тех же пределах Т е превышает 50, что связано, как уже отмечалось, с неточными значениями  $\alpha_3$ . Поэтому для Al II примем  $\alpha_t/\alpha_3 = 1$ . Можно показать, что совершаемая при этом погрешность равна погрешности предположения, что уровень 3 Al II заселяется «косвенно»: n<sub>3</sub>=n<sub>0</sub>-n<sub>1</sub>-—  $n_2$ , посредством общего рекомбинационного процесса  $n_0 R_{1c} = n_e \cdot n_+ \alpha_l$ .

Подчеркнем, что как и в [2], при выводе (9) предполагалась одно-

Таблица 1

АТОМНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОТНОШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ЛИНИЙ МЕТОДОМ С Ш

1	λ <sub>1</sub> Α	λ <sub>2</sub> Α	Q <sub>13</sub>	81	7.1 8B	а <sub>10</sub> см <sup>2</sup>	$a_3(T_e)  \mathrm{cm}^3  \mathrm{c}^{-1}$ $T_e,  \mathrm{K}$				$\frac{\alpha_t(T_e) \text{ cm}^3 \text{ c}^{-1}}{T_e, \text{ K}}$			
							СШ	1908	1176	1.01	1	47.9	1.4-18	3.76-12
Mg I	4568	2780	1.27	1	7.65	9.38-18	5.11-13	1.22-12	3.43-12	5.11-12	1.31-12	3.14-12	8.79-12	1.31-11
Al II*	2666	1766	8.47	1	18.8	3.81-18	9.47-14	8.47-14	6.92-14	5.99-14	4.89-12	4.94-12	4.93-12	4.84-12
Si II	2334	1351	13.7	6	16.3	2.19-18	2.68-13	3.00-13	1.29-12	3.87-12	1.24-12	1.39-12	5.9912	1.79-11
Si III	1888	1300	5.43	1	33.5	2.1418	6.65-12	3.31-11	3.21-10	1.05—09	1.6811	8.35-11	8.11—10	2,66-09

\*) a3 — без учета дизлектронной рекомбинации

родность туманности по плотности и температуре, а спектр излучения возбуждающей звезды считался чернотельным.

Рассчитанные с помощью (9) кривые зависимости отношений интенсивностей линий от температуры ядра приведены на рис. 1—5, при  $W = 10^{-14}$ ,  $n_s = 10^4$  см<sup>-3</sup>. Чтобы определить с помощью этих зависимостей



Рис. 1. Зависимость величины R (С III) от температуры ядра и туманности при  $IW = 10^{-14}$  и  $n_p = 10^4$  см<sup>-3</sup>.



Рис. 2. То же, что и на рис. 1 для Si III.

•значения T, для конкретных туманностей, кроме наблюдаемого отношения интенсивностей линий (исправленных за межэвездное поглощение), необходимо иметь эначения остальных трех параметров — T, n, w W. Первые два можно определить стандартными методами [9], лучше всего посредством анализируемых линий данного иона. Коэффициент дилюции можно определить, например, следующими способами.

276

Если тума: ность имеет оптическую толщину порядка единицы в частотах псевдорезонансной линии, то в спектре ядра будет видна линия по-



Рыс. 3. То же, что в на рис. 1 для Si II.



Рис. 4. То же, что и на рис. 1 для Al II.



Рыс. 5. То же, что и на рис. 1 для Mg I.

глощения [4], посредством которой можно определить линейный размер туманности [19]. Имея угловые размеры туманности в частотах соответствующей запрещенной линия, нетрудно определить W. 4—155 Если в данной туманности наблюдаются сразу две пары линий, например, С III и Si III, или Si II и Al II, то отношение формул (9) дает выражение, вообще не зависящее от W, а именно

$$R(C \text{ III})/R(\text{Si III}) = 0.5 \cdot \exp\left[\left(\frac{14.4}{T_{*}} + \frac{0.1}{T_{*}}\right) \cdot 11600\right],$$
 (12)

н

$$R (\text{Al II})/R (\text{Si II}) = 0.06 \cdot \exp \left[ \left( \frac{2.48}{T_*} + \frac{0.66}{T_*} \right) \cdot 11600 \right],$$
 (13)

в предположении, что линии С III и Si III, с одной стороны, и Si II и Al II, с другой, возбуждаются в одной и той же области туманности. Результаты расчетов по формулам (12) и (13) практически совпадают с численными (табл. 2) в диапазонах температур ядер 100 000—200 000 и 40 000—80 000 К соответственно.

Таблица 2

P. 1 1 1 2

ОТНОШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ЛИНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ МОДЕЛИ ТУМАННОСТИ:  $n_H = 10^4$  см<sup>-3</sup>,  $H = 10^{17}$  см, РАССТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ГРАНИЦЫ ОТ ЗВЕЗДЫ  $R_0 = 10^{10}$  см, РАДИУС ЗВЕЗДЫ  $R_{-} = 10^{10}$  см

T.	1908 1176	1888 1300	2334 1351	2666 1766	4568 2780	Ŧ,
К	СШ	Si III	Si Il	AIII	Mg I	K
200000	4.1	4.1	_	_	_	20000
150000	4.5	4.3	_		_	16000
100000	9.0	4.8	-			13600
80000	3.8	5.8	62.1	11.1	11.9	10500
60000	5.9	6.4	34.7	10.1	11.8	9000
40000	-	-	16.6	8.9	11.3	5200
100000*	10.8	4.3	-	-	-	10100

\*  $n_H = 10^5 \text{ cm}^{-3}$ 

Наконец, если в спектре туманности наблюдаются линии иона соседней стадии ионизации (например, С II, Si II и т. д.), то из условия фотоионизационного равновесия ионов II и III стадий ионизации W можно выразить через отношение концентраций соответствующих ионов, которое можно найти из наблюдаемого отношения запрещенных линий. Например, для линий ионов углерода имеем:

### ТЕМПЕРАТУРЫ ЯДЕР ПЛАНЕТАРНЫХ ТУМАННОСТЕЙ

$$W = 9.1 \cdot 10^{-17} \frac{n_e}{T_s} \frac{n (C \text{ III})}{n (C \text{ II})} \exp\left(\frac{283040}{T_s}\right).$$
(14)

Правда, в этом случае W соответствует зоне ионизационного равновесия С II—С III, а в (9) необходимо использовать W зоны С III—С IV. Полагая, что они совпадают, можно ошибиться в значении W в несколько раз, что мало скажется на значении  $T_s$ , т. к. из (9) следует, что изменению  $T_s$ , например, в 2 раза, соответствует изменение W на 2 порядка. К тому же стратификации излучения туманностей в линиях ионов углерода и не должно наблюдаться, ведь  $\tau_{cont}$  ( $C^{+s}$ )  $|_{s=1-4} \leq 0.1$ .

3. Численные расчеты. Благодаря не очень сильной связи между тремя дискретными состояниями 1, 2 и 3 в рассмотренной выше модели иона численное решение соответствующей задачи при дальнейшем увеличении числа дискретных уровней не должно привести, следует полагать, к сильным отклонениям от (9). Тем не менее, такого рода расчеты представляют определенный интерес, в частности для установления траниц применимости втой формулы. За основу при өтом взяты фотоионизационные модели туманностей [4], модернизованные за счет привлечения, помимо атомов H, N, O, Si, еще и He, C, Ne, Mg, Al, S, Ar и Fe. Баланс населенностей ионов Si III, Si II, Al II, Mg I и C III составлялся на основе ударно-рекомбинационного механизма, при втом число учитываемых термов (уровней) равнялось 14, 13, 14, 12 и 8 соответственно. Источники атомных данных указаны выше (раздел 2).

На основе моделей вычислялись величины

$$R = \int n_j A_{j1} h v_{j1} dV / \int n_i A_{ij} h v_{ij} dV, \ i > j$$
(15)

для одного набора параметров туманности нормального химического состава:  $n_{\rm H} = 10^4$  см<sup>-3</sup>, линейная толщина туманности  $H = 10^{17}$  см. Эначения R в зависимости от  $T_s$  приведены в табл. 2. Там же приведены значения средней влектронной температуры  $\overline{T}_s$  для данной модели туманности. Из сравнения значений R, полученных численно и аналитически, следует, что расхождения невелики, и (9) вполне пригодна для использования в условиях туманностей.

## 4. Применение к реальным туманностям.

NGC 3918. R (С III) = 20.4,  $\overline{n_e} = 5000 \text{ см}^{-3}$ ,  $\overline{T_e} = 13000 \text{ K}$ ,  $\overline{W} = 1.11 \cdot 10^{-15}$  [26]. С помощью этих данных получаем из (9):  $T_s = 127000 \text{ K}$ . Поне-ЛТР моделям эффективная температура ядра равна 140000K [26].

279

#### А. Г. ЕГИКЯН

NGC 6572. R (С III) = 15.9 [25],  $T_e$  (С III) = 10700 K [17],  $n_e = 7000 \text{ см}^{-3}$  [20], тогда для ионизиционной температуры ядра получаем при  $W = 10^{-14}$  и  $10^{-15}$  соответственно значения  $T_s = 82\,000$  и 116000 K. В [20] для этой звезды определена «цзетовая температура» из наблюдаемой ионизации гелия и кислорода, равная 75000K.

NGC 7009. R (С III) = 2.9,  $\bar{n_e}$  = 8000 см<sup>-3</sup>,  $\bar{T}_e$  = 11 100 K [18]. W в данном случае можно оценить с помощью соотношения (14). Так как n (С III)/n (С II) для этой туманности равно 82.1 [18], тогда из (9) и (14) получим  $T_s$  = 132 000 K. Это значение температуры ядра характеризует ее излучение за границей ионизации С III ( $\lambda < 260$  A), а полученная с помощью *IUE* кривая распределения энергии в спектре ядра в сбласти  $\lambda < 2040$  A указывает как раз на значение температуры  $T_s \sim 130000$  K [18].

NGC 7662. R (С III) = 7.5 [27],  $T_{\sigma}$  (С III) = 13600 K [17],  $n_{\sigma} = 10^4 \text{ см}^{-3}$  [27],  $W = 1.1 \cdot 10^{-14}$  ( $R_s = 3.2 \cdot 10^{10} \text{ см}$  [28], H = 0.05 пк [29]), и формула (9) дает  $T_s = 118000$  К. Отметим, что занстровская температура втой звезды  $T_z$  (He II) = 113000 К.

В заключение отметим, что поскольку значения параметров  $n_e$  и  $T_e$ планетарных туманностей определяются достаточно уверенно посредством наблюдаемых эмиссионных линий соответствующих ионов, а распределение энергии в хоротковолновых спектрах ядер дает наиболее реалистические значения температур, формулу (9) в этом случае можно использовать также и для независимого определения коэффициента дилюции.

Автор благодарен Г. А. Гурзадяну за постановку задачи и конструктивное обсуждение полученных результатов.

#### Ереванский политехнический институт

## DETERMINATION OF TEMPERATURES OF THE CENTRAL STARS OF PLANETARY NEBULAE

#### A. G. EGIKIAN

The method of the determination of ionization temperatures of the central stars of planetary nebulae by the relation of intensities of two spectral lines of C III controlled by electron impact and photoionization is extended to ions Si III, Si II, Al II and Mg I. The intensities of pseudoresonance lines are derived allowing dielectronic recombination. The results obtained were compared with those numerical calculations by the ionization model of nebula. The method is applied to NGC 3918, 6572, 7009 and 7662.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. G. A. Gurzadyan, Astrophys. and Space Sci., 80, 189, 1981.
- 2. Г. А. Гурвалян, Докл. АН СССР, 292, 304, 1986.
- 3. Г. А. Гурзалян, Сообщ. Бюракан. обсерв., вып. 16, 3, 1955.
- 4. А. Г. Егикян, Астрофизика, 25, 263, 1987.
- 5. А. Г. Егикян. Астрофизвка, 1988 (в лечати).
- 6. P. J. Storey, Mon. Notic. Roy. Astron. Soc., 195, 27P, 1981.
- 7. H. N. Nussbrumer, P. J. Storey, Astron. and Astrophys. Suppl. Ser., 64, 545, 1986.
- 8. J. M. Shull, M. Van Steenberg, Astrophys. J. Suppl. Ser., 48, 95, 1982.
- D. E.Osterbrock. Astrophysics of Gaseous Nebulae, Freeman and Comp., San-Francisco, 1974.
- 10. G. A. Victor, R. F. Stewart, Astrophys. J. Suppl. Ser., 31, 237, 1976.
- 11. W. C. Martin, R. Zalubas, J. Phys. and Chem. Ref. Data, 8, 817, 1979.
- 12. А. Р. Стризанов. Г. А. Одинцова, Таблецы слектральных линий атомов и нонов, Науха, М., 1982.
- 13. Г. А. Гурвадян, Эвездные хромосферы, Наука, М., 1984.
- 14. И. И. Собельман, Введение в теорию атомных спектров, Наука, М., 1977.
- 15. А. Ф. Холтыгин, Т. Х. Феклистова, Вестн. ЛГУ, № 19, 84, 1983.
- 16. R. J. Gould, Astrophys. J., 219, 250, 1978.
- 17. J. B. Kaler, Astrophys. J., 308, 322, 1986.
- 18. M. Perinotto, P. Benvenuti, Astron. and Astrophys., 101, 88, 1981.
- 19. Г. А. Гурзадян, А. Г. Егикян, Докл. АН СССР, 300, 316, 1988.
- 20. В. В. Головатый, В. И. Проник, О. С. Яцык, Изв. Крым. астрофяз. обсерв., 59, 167, 1979.
- 21. Л. А. Вайнштейн, И. И. Собельман, Е. А. Юков, Возбуждение атомов и уширение спектральных линий, Наука, М., 1979.
- 22. А. Ф. Холтызин, Канд. диссертация, Ленинград, 1981.
- C. E. Moore, Atomic Energy Levels and Multiplet Tables. Si II Si IV, NSRDS--NBS 3, Sect. 1, W., 1965.
- 24. W. C. Martin, R. Zalabas, J. Phys. and Chem. Ref. Data, 9, 1, 1980.
- 25. S. Torres-Peimbert, M. Pena, Rev. mex. astron. y astrofis., 6, 301, 1981.
- R. E. S. Clegg, J. P. Harrington, M. J. Barlow, J. R. Walsh, Astrophys. J., 314, 551, 1987.
- 27. J. P. Harrington, M. J. Seaton, S. Adams, J. H. Lutz, Mon. Notic. Roy. Astron. Soc., 199, 517, 1982.
- 28. R. C. Kirkpatrick. Astrophys. J., 176, 381, 1972.
- 29. R. C. Bohlin, J. P. Harrington, T. P. Stecher, Astrophys. J., 219, 575, 1978.